

# Technische Information / technical information

IGBT-Module  
IGBT-modules

# FD800R33KL2C-K\_B5



## Vorläufige Daten preliminary data

### IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter

#### Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	3300 3300	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{C\ nom}$ $I_C$	800 1500	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\ \text{ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{CRM}$	1600	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	9,80	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

#### Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 800\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$ $I_C = 800\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\ sat}$	3,00 3,70	3,65 4,45	V V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 80,0\ \text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{GEth}$	4,2	5,1	6,0	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\ \text{V} \dots +15\ \text{V}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$		$Q_G$	15,0			$\mu\text{C}$
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{Gint}$	0,75			$\Omega$
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$		$C_{ies}$	97,0			nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$		$C_{res}$	5,40			nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 3300\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{CES}$			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\ \text{V}, V_{GE} = 20\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Gon} = 6,8\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ on}$	1,00 1,00			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Gon} = 6,8\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_r$	0,40 0,40			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Goff} = 6,8\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\ off}$	3,70 3,90			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 800\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$ $R_{Goff} = 6,8\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_f$	0,25 0,35			$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 800\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}, di/dt = 4200\ \text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, L_S = 60\ \text{nH}$ $R_{Gon} = 3,0\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	1700 2250			mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 800\ \text{A}, V_{CE} = 1800\ \text{V}$ $V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, L_S = 60\ \text{nH}$ $R_{Goff} = 6,8\ \Omega, C_{GE} = 220\ \text{nF}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	900 1250			mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}, V_{GE} \leq 15\ \text{V}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 2500\ \text{V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$		$I_{SC}$	3500			A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT		$R_{thJC}$			13,0	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$			12,0	K/kW

prepared by: Karl-Heinz Hoppe  
approved by: Thomas Schütze

date of publication: 2004-4-8  
revision: 2.0

Vorläufige Daten  
preliminary data

## Diode-Wechselrichter / diode-inverter

## Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = -25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	3300 3300	V
Dauergleichstrom DC forward current		$I_F$	800	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	1600	A
Grenzlastintegral $I^2t$ - value	$V_R = 0 \text{ V}$ , $t_P = 10 \text{ ms}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	230	$\text{kA}^2\text{s}$
Spitzenverlustleistung maximum power dissipation	$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$P_{RQM}$	1200	kW
Mindesteinschaltdauer minimum turn-on time		$t_{Fon \min}$	10,0	$\mu\text{s}$

## Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_F$	2,60 2,55	t.b.d.	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 800 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 4200 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 1800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	1050 1200		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 800 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 4200 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 1800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	540 960		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 800 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 4200 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 1800 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	500 1000		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode		$R_{thJC}$		25,5	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		$R_{thCH}$	24,0		K/kW

prepared by: Karl-Heinz Hoppe

date of publication: 2004-4-8

approved by: Thomas Schütze

revision: 2.0

# Technische Information / technical information

IGBT-Module  
IGBT-modules

## FD800R33KL2C-K\_B5



### Vorläufige Daten preliminary data

#### Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V <sub>ISOL</sub>	10,2		kV
Teilentladungs Aussetzspannung partial discharge extinction voltage	RMS, f = 50 Hz, Q <sub>PD</sub> typ 10 pC (acc. to IEC 1287)	V <sub>ISOL</sub>	5,1		kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung DC stability	T <sub>vj</sub> = 25°C, 100 fit	V <sub>CE D</sub>	2150		V
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			AlSiC		
Material für innere Isolation material for internal insulation			AlN		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		64,0 56,0		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		40,0 26,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 600		
			min.	typ.	max.
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ <sub>Paste</sub> = 1 W/(m·K) / λ <sub>grease</sub> = 1 W/(m·K)	R <sub>thCH</sub>		6,00	K/kW
Modulinduktivität stray inductance module		L <sub>sCE</sub>		20	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T <sub>c</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch	R <sub>CC'+EE'</sub> R <sub>AA'+CC'</sub>		0,18 0,37	mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature	Wechselrichter / inverter	T <sub>vj max</sub>			150 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions	Wechselrichter / inverter	T <sub>vj op</sub>	-40		125 °C
Lagertemperatur storage temperature		T <sub>stg</sub>	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M6	M	4,25	-	5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	Schraube / screw M4 Schraube / screw M8	M	1,8 8,0	-	2,1 10 Nm
Gewicht weight		G		1400	g

Modulinduktivität: IGBT (Zweig 1+2 parallel): 20nH; Diode (Zweig 3): 25nH  
stray inductance module: IGBT (arm 1+2 parallel): 20 nH; diode (arm 3): 25nH

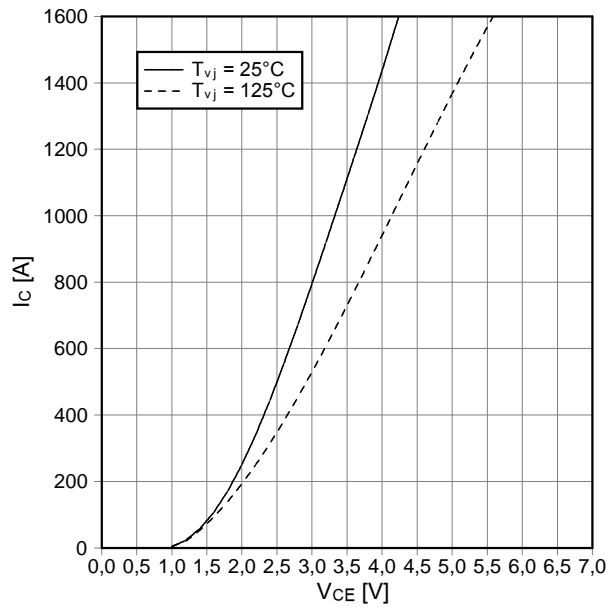
**Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.**

**This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.**

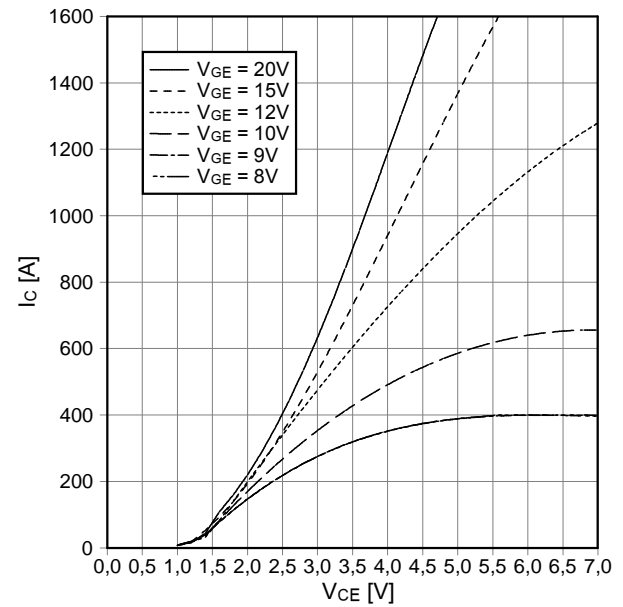
prepared by: Karl-Heinz Hoppe	date of publication: 2004-4-8
approved by: Thomas Schütze	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

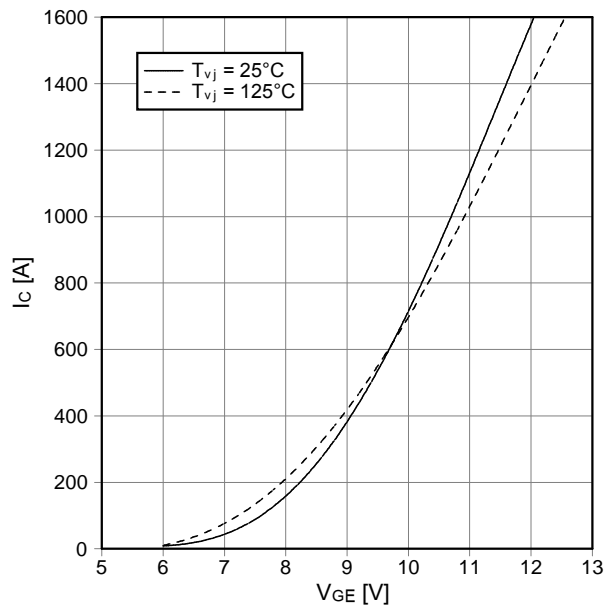
**Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**  
 $I_c = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



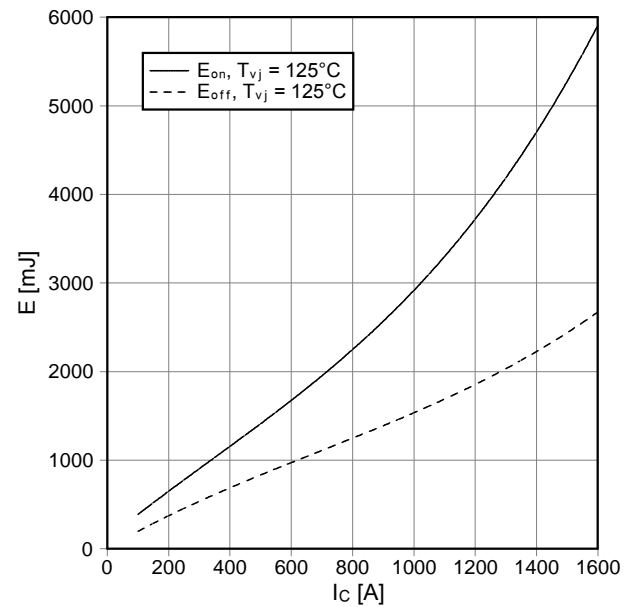
**Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**output characteristic IGBT-inverter (typical)**  
 $I_c = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



**Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT-inverter (typical)**  
 $I_c = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



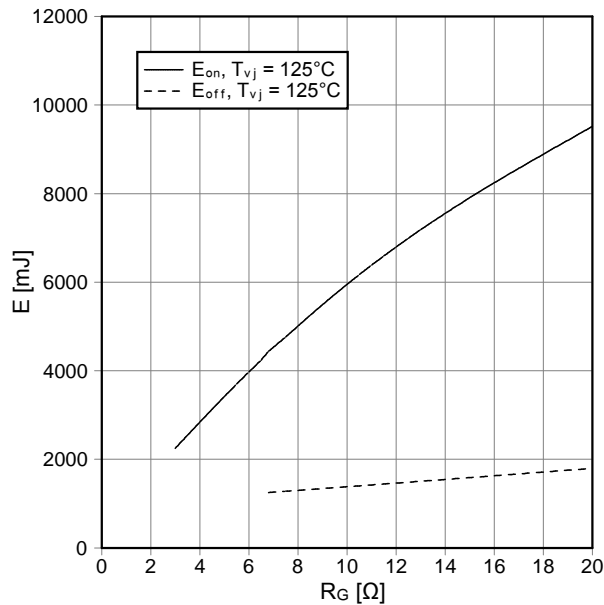
**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses IGBT-inverter (typical)**  
 $E_{on} = f(I_c)$ ,  $E_{off} = f(I_c)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 3\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 6,8\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 1800\text{ V}$ ,  
 $C_{GE} = 220\text{ nF}$



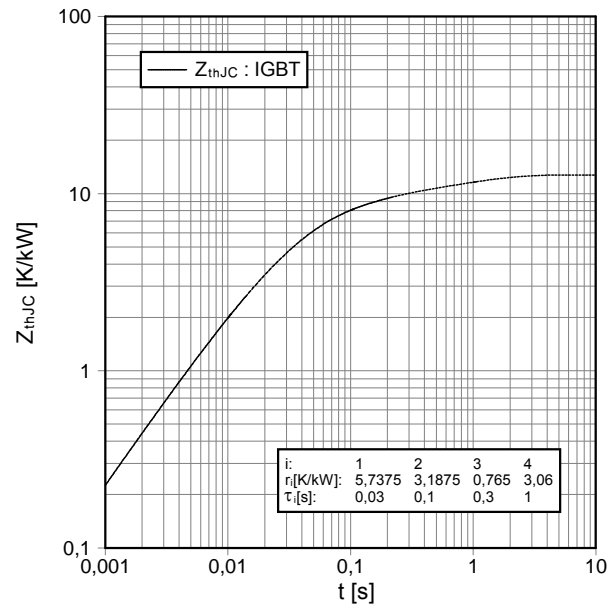
prepared by: Karl-Heinz Hoppe	date of publication: 2004-4-8
approved by: Thomas Schütze	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

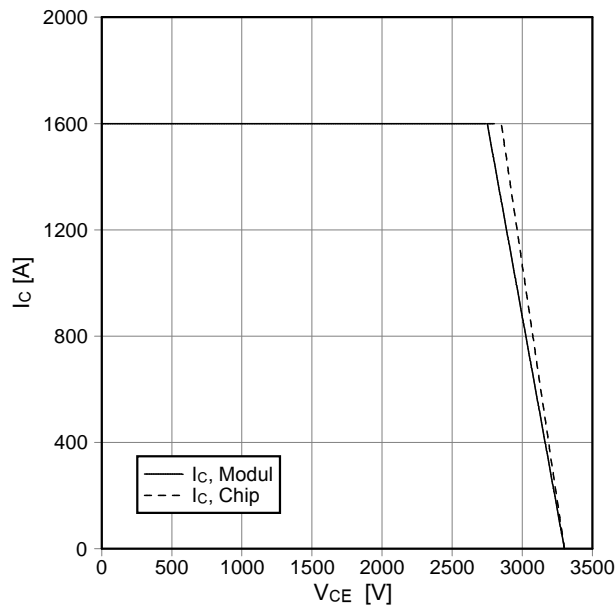
**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses IGBT-Inverter (typical)**  
 $E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_c = 800\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 1800\text{ V}$ ,  $C_{GE} = 220\text{ nF}$



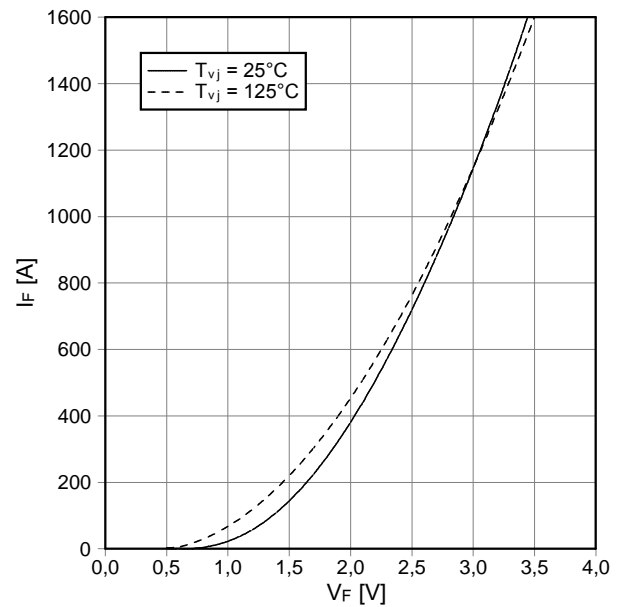
**Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.**  
**transient thermal impedance IGBT-inverter**  
 $Z_{thJC} = f(t)$



**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)**  
**reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)**  
 $I_c = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 6,8\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ ,  $C_{GE} = 220\text{ nF}$



**Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)**  
**forward characteristic of diode-inverter (typical)**  
 $I_F = f(V_F)$



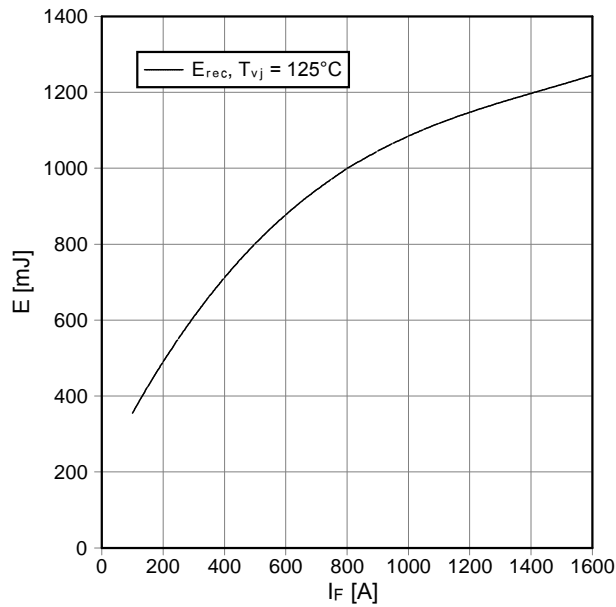
prepared by: Karl-Heinz Hoppe	date of publication: 2004-4-8
approved by: Thomas Schütze	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
preliminary data

Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)  
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$

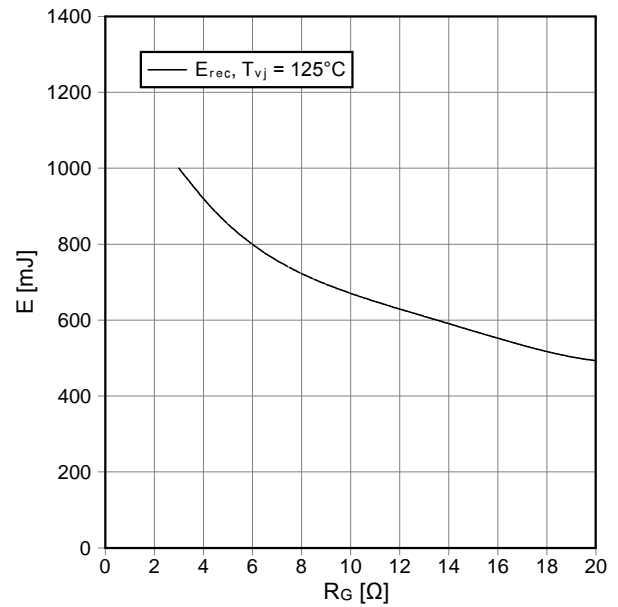
$R_{Gon} = 3 \Omega, V_{CE} = 1800 V$



Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)  
switching losses diode-inverter (typical)

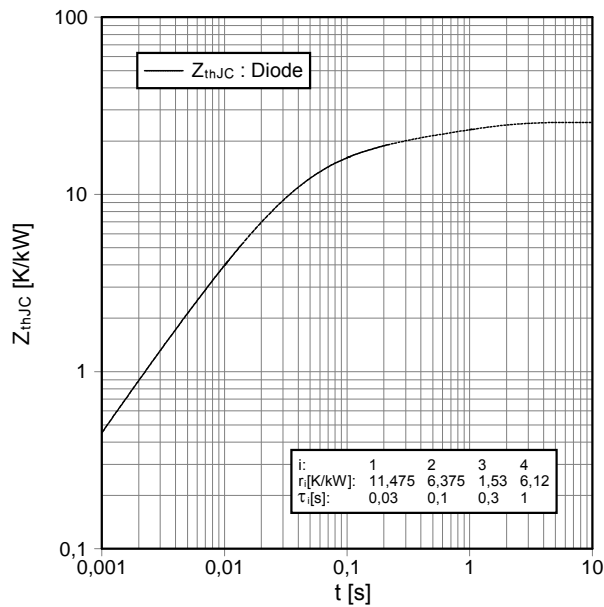
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 800 A, V_{CE} = 1800 V$



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.  
transient thermal impedance diode-inverter

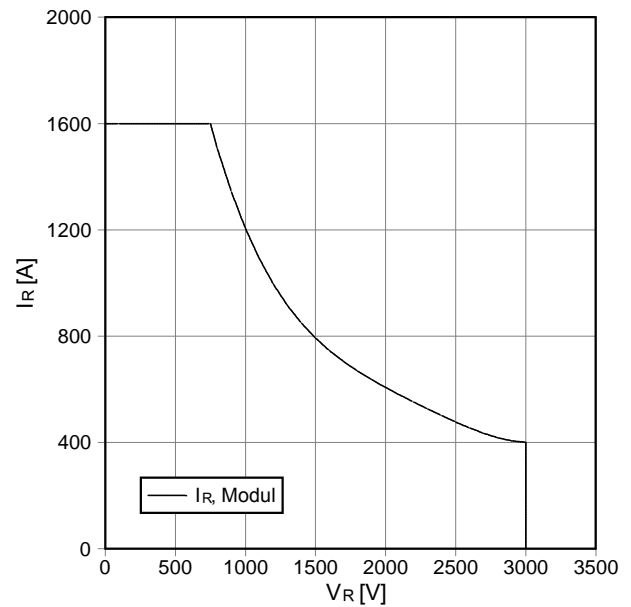
$Z_{thJC} = f(t)$



Sicherer Arbeitsbereich Diode-Wechselr. (SOA)  
safe operation area diode-inverter (SOA)

$I_R = f(V_R)$

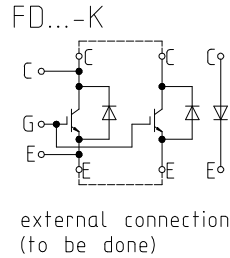
$T_{vj} = 125^\circ C$



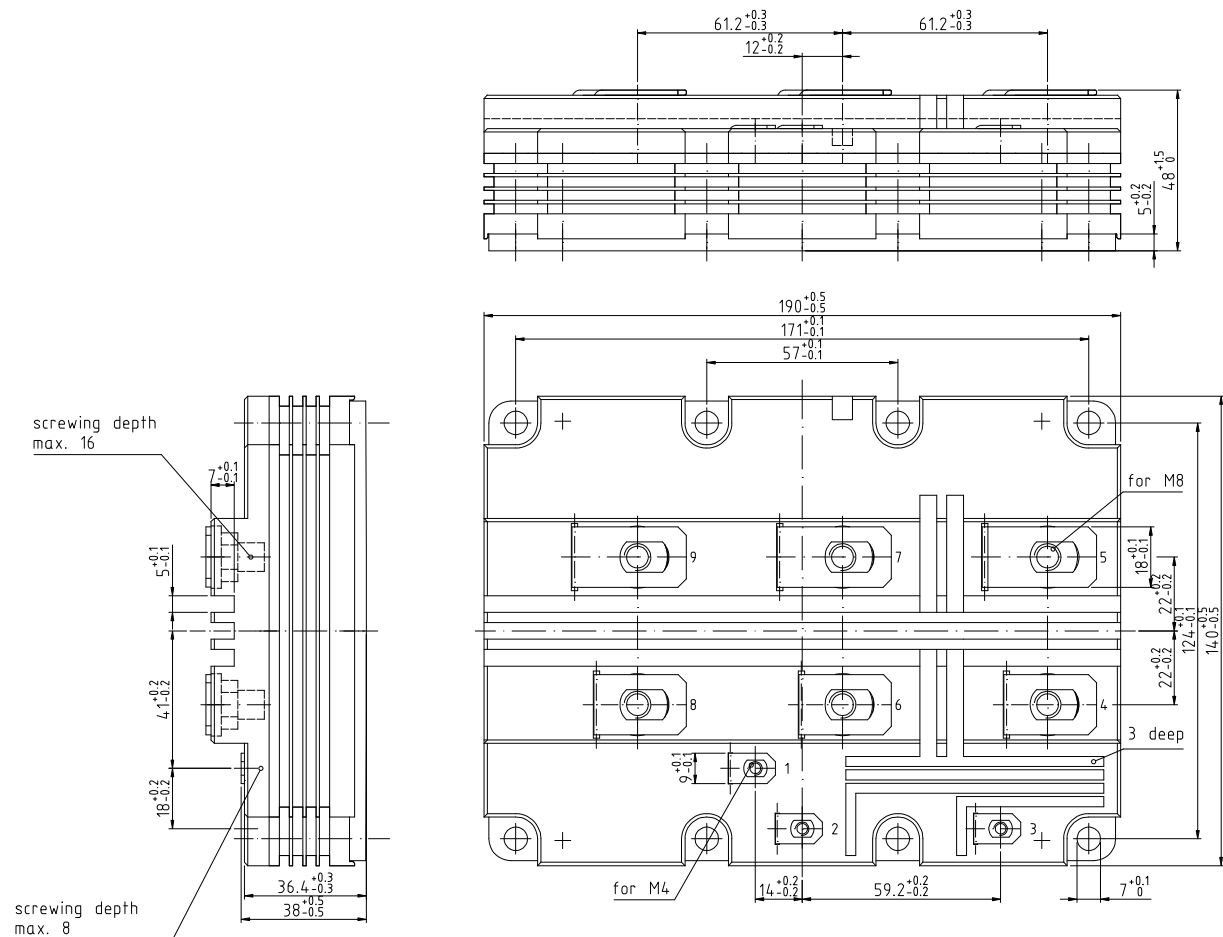
prepared by: Karl-Heinz Hoppe	date of publication: 2004-4-8
approved by: Thomas Schütze	revision: 2.0

**Vorläufige Daten**  
**preliminary data**

**Schaltplan / circuit diagram**



**Gehäuseabmessungen / package outlines**



prepared by: Karl-Heinz Hoppe	date of publication: 2004-4-8
approved by: Thomas Schütze	revision: 2.0

## Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant to the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.